



[所内邮箱](#)
 用户名:
 密 码:
[所长信箱](#) | [留言信箱](#)



现在位置: [首页](#) > [国际合作](#) > [国际交流动态](#)

- [国际合作](#)
[· 国际交流动态](#)
[· 国际合作项目](#)
[· 国际会议](#)
[· 国际组织任职](#)

香港大学郑耀宗院士来访

发表日期: 2006-06-15

应中国科学院理化技术研究所的邀请,中国科学院院士、香港城市大学前任校长、香港大学前任校长郑耀宗教授于6月8日下午来理化所访问,理化所赵震声副所长会见了到访嘉宾,并向郑耀宗院士颁发了理化技术研究所客座教授的聘书。在赵震声副所长、李述汤院士、张晓宏研究员的陪同下,双方交流了彼此感兴趣研究课题,就未来合作领域进行了商谈。

郑耀宗院士简介:

微电子学专家。原籍广东中山,生于香港。1963年毕业于香港大学,获理学学士学位。1967年获加拿大卑诗大学博士学位。1989-1996年任香港城市大学校长,1996-2000年任香港大学校长。郑耀宗教授长期以来对金属-二氧化硅-硅(MOS)系统及其器件物理和工艺技术进行了系统研究。发明了掺氟化氢硅氧化技术,解决了当时MOS器件和集成电路阈值电压漂移、不能稳定工作的难题,使MOS器件和电路的性能、可靠性和成品率大大提高。在国际上首先提出了MOS反型层载流子表面粗糙度散射理论,在MOS集成电路进入深亚微米阶段后,这一机理已成为决定MOS反型层载流子迁移率的主要因素,这是对MOS器件物理的一大发展。是较早开展氮化硅技术的研究者之一。在深亚微米器件模型研究工作中取得重要成果。1999年当选为中国科学院院士。

业务处



理化所客座教授郑耀宗院士

>> 评论



版权所有：中国科学院理化技术研究所 Copyright © 2002-2008
地址：中国·北京 京ICP备05002791号